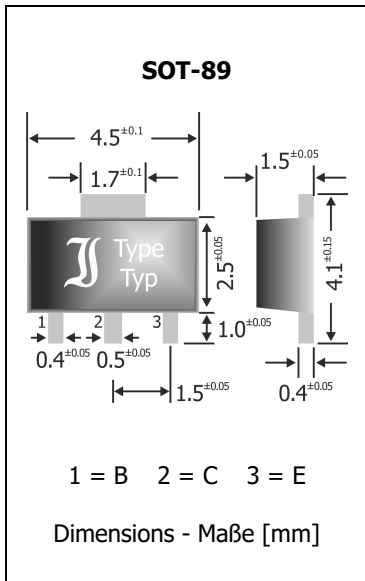


BCX53 SMD General Purpose PNP Transistors SMD Universal-PNP-Transistoren	I_C = -1 A h_{FE} > 63/250 T_{jmax} = 150°C	V_{CEO} = -80 V P_{tot} = 0.5 W
---	--	--

Version 2020-04-02



Typical Applications

Signal processing,
Switching, Amplification
Commercial grade ¹⁾

Features

High collector current
Low saturation voltage
Three current gain groups
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled
Weight approx.
Case material
Solder & assembly conditions



tbd
0.04 g
UL 94V-0
260°C/10s
MSL = 1

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung,
Schalten, Verstärken
Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Hoher Kollektorstrom
Niedrige Sättigungsspannung
Drei Stromverstärkungsklassen
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
Gewicht ca.
Gehäusematerial
Löt- und Einbaubedingungen

Type Code	Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren
BCX53 = AH BCX53-10 = AK BCX53-16 = AL	BCX56

Maximum ratings ²⁾

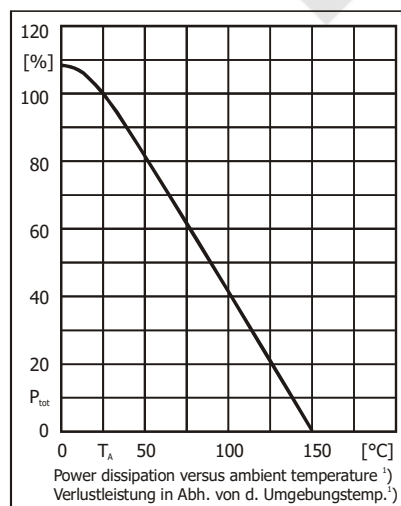
Grenzwerte ²⁾

			BCX53
Collector-Emitter-voltage – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V _{CEO}	80 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	- V _{CBO}	100 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	- V _{EBO}	5 V
Power dissipation Verlustleistung	T _S = 120°C	P _{tot}	0.5 W ³⁾
Collector current Kollektorstrom	DC	- I _C	1 A
Peak Collector current Kollektor-Spitzenstrom		- I _{CM}	2.0 A
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T _J	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _S	-55...+150°C

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
2 T_A = 25°C, unless otherwise specified – T_A = 25°C, wenn nicht anders angegeben
3 Measured at collector terminal 2 – Gemessen am Kollektor-Anschluss 2

Characteristics
Kennwerte

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾					
- $V_{CE} = 2\text{ V}$, - $I_C = 5\text{ mA}$	all groups	h_{FE}	63	–	–
- $V_{CE} = 2\text{ V}$, - $I_C = 150\text{ mA}$	BCX53	h_{FE}	63	–	250
	BCX53-10	h_{FE}	63	–	160
	BCX53-16	h_{FE}	100	–	250
- $V_{CE} = 2\text{ V}$, - $I_C = 500\text{ mA}$	all groups	h_{FE}	25	–	–
Collector-Base breakdown voltage – Kollektor-Basis-Abbruch-Spannung					
- $I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$, (E open)		- $V_{(BR)CBO}$	100 V	–	–
Collector-Emitter breakdown voltage – Kollektor-Emitter-Abbruch-Spannung					
- $I_C = 10\text{ mA}$, (B open)		- $V_{(BR)CEO}$	80 V	–	–
Emitter-Base breakdown voltage – Emitter-Basis-Abbruch-Spannung					
- $I_E = 100\text{ }\mu\text{A}$, (C open)		- $V_{(BR)EBO}$	5 V	–	–
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung ¹⁾					
- $I_C = 500\text{ mA}$, - $I_B = 50\text{ mA}$		- V_{CEsat}	–	–	0.5 V
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung ¹⁾					
- $V_{CE} = 2\text{ V}$, - $I_C = 500\text{ mA}$		- V_{BE}	–	–	1 V
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom					
- $V_{CB} = 30\text{ V}$, (E open)		- I_{CBO}	–	–	100 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom					
- $V_{EB} = 5\text{ V}$, (C open)		- I_{EBO}	–	–	100 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
- $V_{CE} = 5\text{ V}$, - $I_C = 10\text{ mA}$, $f = 100\text{ MHz}$		f_T	–	50 MHz	–
Typical thermal resistance junction to ambient Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung		R_{thA}	250 K/W ²⁾		



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
- 2 Mounted on P.C. board with 600 mm² copper pad at the collector terminal
Montage auf Leiterplatte mit 600 mm² Kupferbelag (Löt-pad) am Kollektor-Anschluss

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):

Click to view products by [Diodec manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NTE158](#) [NTE187A](#) [NTE195A](#) [NTE2302](#) [NTE2330](#) [NTE63](#) [C4460](#)
[2SA1419T-TD-H](#) [2SA1721-O\(TE85L,F\)](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC5488A-TL-H](#) [2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [2N2369ADCSM](#)
[2N5769](#) [2SC2412KT146S](#) [2SC5490A-TL-H](#) [2SD1816S-TL-E](#) [2SD1816T-TL-E](#) [CMXT2207 TR](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#)
[US6T6TR](#) [NJL0281DG](#) [732314D](#) [CMXT3906 TR](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#)
[NJL0302DG](#) [TTA1452B,S4X\(S](#) [2N3583](#) [NTE103](#) [30A02MH-TL-E](#) [NSV40301MZ4T1G](#) [NTE101](#) [NTE13](#) [NTE15](#) [NTE16001](#) [NTE16006](#)
[NTE26](#)